

Difusión	Implantación
Proceso de alta temperatura	Temperatura ambiente
Fuente de dopantes: sólido, líquido o gaseoso	Fuente de dopantes: iones
Temperatura repara defectos en silicio durante el proceso	Causa daños al silicio, requiere tratamiento posterior de alta temperatura para reparar los daños
Permite dopados de alta concentración, materiales resultantes de baja resistividad	Dopados con concentraciones menores, 10 veces mayor resistividad
Menos precisión (concentración y profundidad)	Proceso de alta precisión (concentración y profundidad)